

第 90117772 號專利申請案

申請專利範圍更正本

(修正替換頁)
更正
包含使用含鉍離

1. 一種在介電表面上製造導體層之方法，
子濃度 0.005M 至 0.3M 之鉍材料溶液及硫材料處理基板，該硫材料係選自硫化鈉、硫化鉀、有機硫化物及其混合物，其中基板表面包含介電質材料，以及基板接受金屬鍍層。
2. 如申請專利範圍第 1 項之方法，其中該基板係使用三價鉍處理。
3. 如申請專利範圍第 1 或 2 項之方法，其中該基板係電解鍍鎳。
4. 如申請專利範圍第 1 或 2 項之方法，其中該基板係電解鍍銅。
5. 如申請專利範圍第 1 或 2 項之方法，其中該基板係電解鍍金。
6. 如申請專利範圍第 1 或 2 項之方法，其中該基板於使用鉍材料處理前係以蝕刻劑處理。
7. 如申請專利範圍第 1 或 2 項之方法，其中該基板表面包含環氧樹脂、ABS 或聚醚醯亞胺。
8. 如申請專利範圍第 1 或 2 項之方法，其中該基板為電子封裝基板。
9. 如申請專利範圍第 1 或 2 項之方法，其中該金屬鍍層提供裝飾或保護功能。

- 10.如申請專利範圍第 1 或 2 項之方法，其中該基板於使用鉍材料處理後而於使用硫化物材料處理前係使用水處理。
- 11.一種製造物件，包括一片基板具有金屬沉積物，該金屬沉積物係經由如申請專利範圍第 1 至 10 項中任一項之方法提供。
- 12.一種製造物件，包含一片基板具有電解金屬沉積於其上，以及鉍材料於金屬沉積物下方，以及硫進一步位於該鉍材料下方，該硫係選自硫化鈉、硫化鉀、有機硫化物及其混合物，該金屬沈積物係經由如申請專利範圍第 1 至 10 項中任一項之方法提供。
- 13.如申請專利範圍第 12 項之物件，其中該金屬係沉積於介電質層上方。
- 14.如申請專利範圍第 12 項之物件，其中該金屬係沈積於介電質層上方。
- 15.如申請專利範圍第 12 至 14 項中任一項之物件，其中該基板為電子封裝基板。
- 16.如申請專利範圍第 12 至 14 項中任一項之物件，其中該金屬沈積物提供裝飾或保護功能。
- 17.如申請專利範圍第 12 至 14 項中任一項之物件，其中該基板為電磁屏障材料。